

【裁判字號】102,智易,10

【裁判日期】1040430

【裁判案由】妨害秘密

【裁判全文】

臺灣新竹地方法院刑事判決 102年度智易字第10號

公 訴 人 臺灣新竹地方法院檢察署檢察官

被 告 連水池

選任辯護人 周金城律師

周奇杉律師

被 告 王宜凡

選任辯護人 許玉娟律師

上列被告等人因妨害秘密案件，經檢察官提起公訴（101 年度偵字第10325 號、102 年度偵字第2791號），本院判決如下：

主 文

連水池、王宜凡均無罪

理 由

一、公訴意旨略以：

（一）被告連水池原在址設新竹市○○○路0 號「友達光電股份有限公司」（下稱「友達公司」）擔任顯示器技術開發中心資深協理。友達公司乃國內顯示器製造技術領先廠商，關於顯示器之製程，包括標準作業流程、研發關鍵技術、檔案、生產設備及機器參數等資料與技術，均為友達公司極為重要之機密資訊，如為他人取得，彼等即可鉅幅減少研發時程及耗費成本，友達公司之競爭優勢及權益，勢必蒙受嚴重損失。而被告連水池所擔任職務為顯示器技術開發中心最高主管，得任意取得、接觸及下載中心內部相關資料。緣被告連水池於民國100 年4 月間經由友人介紹而有意至中國大陸地區華星光電技術有限公司（下稱「華星公司」）之母公司「TCL 」集團任職，明知依契約對友達公司負有保守因職務關係所知悉或持有工商秘密之義務，不得洩漏予他人知悉，且華星公司與友達公司為競爭關係，詎被告連水池為獲取跳槽後之高額薪水及獎金，竟基於妨害秘密之犯意，於100 年9 月15日自友達公司離職前之某日，利用其本身具有可下載友達公司營業機密資料及使用個人電腦、隨身碟之權限，從友達公司內部資料伺服器下載如附表一所示之投影片檔案後，於100 年9 月19日前往中國大陸地區擔任「TCL 」集團工業研究院副院長，並將前開檔案內之機密圖檔洩漏予「TCL 」集團及華星公司，使華星公司生產之液晶顯示器亦能擁有友達公司之PSA

等技術。

(二) 被告王宜凡原係友達公司OLED技術處經理。緣被告王宜凡於100年5月間經由友人介紹而有意至華星公司任職，明知依契約對友達公司負有保守因職務關係所知悉或持有工商秘密之義務，不得洩漏予他人知悉，且華星公司與友達公司為競爭關係，詎被告王宜凡為獲取跳槽後之高額薪水及獎金，竟基於妨害秘密之犯意，於100年5月2日至同年9月29日期間，接續將儲存在友達公司所有之電腦內如附表二所示之工商秘密，以友達公司配發其使用之電子郵件信箱（帳號：Ivan.YF.Wang@auo.com）寄送至其私人所有之電子郵件信箱（帳號：ivanauo@yahoo.com.tw）後，於100年9月30日自友達公司離職並前往華星公司擔任AMOLED開發部部長，並將上開友達公司所有之工商秘密資料洩漏予華星公司知悉。因認被告連水池、王宜凡均涉犯刑法第318條之2、第317條之利用電腦設備洩漏工商秘密罪嫌等語。

二、刑法第317條之罪，須告訴乃論，同法第319條定有明文。又告訴乃論之罪，其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於6個月內為之，刑事訴訟法第237條第1項定有明文。本案告訴人友達公司（下稱告訴人公司）主張其係於被告連水池100年9月15日離職後、王宜凡100年9月30日離職後，始知悉被告連水池、王宜凡涉有妨害秘密之犯行，並於101年1月17日向法務部調查局臺北市調處具狀提出告訴，有調查筆錄在卷可參（101年度他字第2094號卷《下稱他2094卷》一第3至15頁），形式上確在知悉犯人起6個月內提出告訴，追訴條件應已具備，應先敘明。

三、有罪之判決書應於理由內記載認定犯罪事實所憑之證據及其認定之理由。刑事訴訟法第154條第2項及第310條第1款分別定有明文。而犯罪事實之認定，係據以確定具體的刑罰權之基礎，自須經嚴格之證明，故其所憑之證據不僅應具有證據能力，且須經合法之調查程序，否則即不得作為有罪認定之依據。倘法院審理之結果，認為不能證明被告犯罪，而為無罪之諭知，即無前揭第154條第2項所謂「應依證據認定」之犯罪事實之存在。因此，同法第308條前段規定，無罪之判決書只須記載主文及理由。而其理由之論敘，僅須與卷存證據資料相符，且與經驗法則、論理法則無違即可，所使用之證據亦不以具有證據能力者為限，即使不具證據能力之傳聞證據，亦非不得資為彈劾證據使用。故無罪之判決書，就傳聞證據是否例外具有證據能力，本無須於理由內論敘

說明（最高法院100 年度台上字第2980號判決要旨參照）。據此，本件依本院審理之結果，乃認為不能證明被告連水池、王宜凡犯罪，而為被告連水池、王宜凡無罪之諭知（詳如後述），則無論係檢察官或被告連水池、王宜凡出證提出之各項證據方法，均經本院經合法之調查程序進行調查，並予以當事人辯論，縱係屬傳聞證據，自均非不得資為彈劾證據使用，而無證據容許資格之限制，核先敘明。

四、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，刑事訴訟法第154 條第2 項定有明文，又認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，自應為被告無罪之判決，最高法院76年度台上字第4986 號判例意旨可資參照。次按檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，刑事訴訟法第161 條第1 項定有明文。故檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知，最高法院92年度台上字第128 號判例意旨參照。再按，刑事被告並無自證己罪之義務，其在訴訟上所為之辯解，只須達於對起訴事證提出合理質疑之程度為已足，檢察官如對被告所舉反證仍有爭執，即應依刑事訴訟法第161 條規定積極舉證釋疑。被告等既堅決否認犯罪，檢察官所舉證據復不足以使法院產生有罪之心證，原判決因認被告等犯罪不能證明，於法尚無不合，最高法院97年度台上字第3099號判決意旨參照。依上開最高法院判例及判決意旨可知，基於被告無自證己罪之義務，被告對於檢察官所起訴之事證所為之辯解，只須使法院達於合理懷疑之程度即可，檢察官如有爭執，即須依刑事訴訟法第161 條積極舉證，惟檢察官所舉證據如不足以使法院對被告產生有罪確信之心證，基於無罪推定之原則，法院即應為被告無罪判決之諭知。至告訴人之告訴，本以使被告受刑事訴追為目的，是以告訴人之指訴為證據方法，除其指訴須無瑕疵，且應有查與事實相符之佐證，始得資為判決之基礎，亦經最高法院著有52年台上字第1300號及61年台上字第3099號判例可資參照。而所謂無瑕疵，係指被害人所為不利被告之陳述，與社會上一般生活經驗或卷存其他客觀證據並無矛盾而言；另所謂就其他方面調查認與事

實相符，非僅以所援用之旁證足以證明被害結果為已足，尤須綜合一切積極佐證，除認定被告確為加害人之可能外，在推理上無從另為其他合理原因之假設，有一不合於此，即不能以被害人之陳述作為論斷之證據。又按刑法第317 條洩漏業務上知悉工商秘密罪，係以依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，而無故洩漏之者為要件，換言之，唯有依法令或契約解釋可認為工商秘密者，始能成為該條之行爲客體，若依法令或契約解釋無從認為係屬工商秘密者，自難以該罪相繩。又所謂「工商秘密」，係指工業上或商業上之秘密事實、事項、物品或資料，而非可舉以告人者而言，重在經濟效益保護，是舉凡工業上之製造秘密、專利品之製造方法、商業之營運計畫、企業之資產負債情況及客戶名錄等，就工商營運利益如屬不能公開之資料，均屬本罪所應加以保護之工商秘密。另刑法對所謂工商秘密之定義雖未有何明文，然營業秘密法第2 條已規定：本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。是刑法第317 條所謂之「工商秘密」或「秘密」，至少亦須具備上開要件，始足當之。從而，刑法第317 條所定之「工商秘密」，亦重在經濟效益之保護，且客觀上仍需具有不公開性，即非該行業所熟知或習見之資訊或者技術，並具有一定經濟價值，始足當之，客觀上並非僅以「不公開性」為要件，亦不以營業人主觀上認為秘密為認定之唯一標準。

五、公訴意旨認被告連水池、王宜凡涉有犯刑法第318 條之2 、第317 條之利用電腦設備洩漏工商秘密罪嫌，無非係以被告連水池、王宜凡於調詢及偵查中供述、告訴代理人即告訴人公司法務副理桑和蓓於調詢及偵查中之指訴、證人即告訴人公司科技總部副總經理盧勇宏於偵查中證述、告訴人公司智慧財產權處處長余義勝於偵查中證述、告訴人公司承接被告王宜凡業務之員工徐士峰於偵查中證述、告訴人公司電視面板設計部經理黃韋凱於偵查中證述、陳立宜於100 年4 月24 日寄發予連水池之電子郵件1 紙、告訴人公司員工手冊及資訊安全管理規定1 份、告訴人公司對被告連水池所使用之電腦所出具之筆記型電腦使用紀錄暨行爲分析各1 份、告訴人公司LCD TV 2012 Q2 Product Roadmap 投影片1 份、法務部調查局臺北市調處101 年11月27日北維字第00000000000 號函及附件1 份、被告連水池於100 年7 月8 日在告訴人公司

製作之投影片檔案1份、告訴人公司PSA Technology之投影片檔案1份、財團法人中華工商研究院PSA 技術比對分析鑑定研究報告書2份、面板型號「T420HW08」與面板型號「MT4601B02」之檢測過程現況證明報告書1份、友達公司研發人員2008年提出有關四道光罩通道設計取向之研發報告（含中譯本）1份、2009年有關四道光罩元件特性提升之資料1份、TCL 集團股份有限公司2012年度報告第16頁1紙、被告王宜凡聘僱契約及簽署之離職人員營業秘密及智慧財產權遵守聲明書各1份、被告王宜凡寄發如附表二所示之電子郵件及其附件1份、王宜凡所使用Ivan .YF .Wang@auo .com 電子郵件信箱於100年1月1日至同年9月30日之紀錄1份、被告王宜凡所使用ivanauo @yahoo .com .tw 電子郵件信箱於100年10月1日所寄送之郵件及新竹地檢署檢察事務官101年度偵字第10325號勘驗報告1份、華星公司（發明人為王宜凡）在中國大陸申請之「紫外有機發光裝置」及「有機電致發光二極管有機材料蒸鍍用掩模裝置」等發明專利申請書各1份資為論述之依據。

六、訊據被告連水池固坦承自92年至100年9月15日間擔任告訴人公司顯示器技術開發中心資深協理時，其主要負責業務為管理顯示器技術方面的開發與研發，並為顯示器技術開發中心最高主管，且依據其在告訴人公司的職務，得任意接觸告訴人公司顯示器技術開發中心內部之相關資料，其自告訴人公司離職後，於100年9月19日至華星公司之母公司「TCL」集團任職，擔任工業研究院副院長職務，並兼任華星公司顧問，協助華星公司解決顯示器技術上的問題等事實；被告王宜凡則坦承於100年9月30日自告訴人公司離職，離職前擔任告訴人公司OLED的開發部經理，並於100年10月中至華星公司擔任該公司AMOLED開發部部長，其任職於告訴人公司期間，曾於100年5月2日至100年9月29日，接續將儲存在告訴人公司所有之電腦內之如起訴書附表二所示之檔案，以告訴人公司配發供其使用之電子郵件信箱，寄送至其私人所有之電子郵件信箱等事實，惟被告連水池、王宜凡均堅詞否認有何利用電腦設備洩漏工商秘密之犯行，被告連水池辯稱：我在告訴人公司任職期間，並沒有跟告訴人公司簽訂應保守因職務關係所知悉或持有工商秘密的相關契約，在離開告訴人公司前也沒有下載如起訴書附表一各編號所示之投影片，存放於扣案筆記型電腦電子郵件附檔中之華星光電研發中心技術及產品規劃報告（下稱華星公司規劃報告），是華星公司員工賴梓杰於2012年1月10日用e-mail傳給我的

，不是我製作的，而且規劃報告中第4 頁左圖「HVA 技術」、第5 頁「4-mask技術」的圖檔，在公開資訊如學術論文、公開專利或公司網頁上都可以查得到，這些是公開的技術，不是告訴人公司的秘密，而且上述華星公司規劃報告內的「HVA 技術」及「4-mask技術」圖檔也與起訴書附表一編號1、2 所示之圖檔不一樣等語；其辯護人則以：被告連水池與告訴人公司間並無保密契約，並非刑法第317 條依法令或契約有守密義務之人，被告連水池並未使用非公司網域電腦連接公司內部電腦網路存取資源之行爲，也無將告訴人公司資料帶到大陸TCL 公司或華星公司，被告連水池扣案筆記型電腦內之華星公司規劃報告投影片檔案之「HVA 技術」及「4-mask」圖檔，與起訴書附表一編號1、2 之圖檔，並不完全相同。且華星公司規劃報告之「HVA 技術」及「4-mask技術」圖檔所表達之技術早已於公開論文、專利公告及公開網頁中揭露、任何相關技術人員均得自公開資訊中取得，絕非秘密，況且，上開華星公司規劃報告，是被告連水池到TCL 公司後，華星公司員工於101 年年初以電子郵件方式寄給被告連水池，而非被告連水池所製作等語爲其辯護；被告王宜凡則辯稱：我在告訴人公司任職期間有簽一份合同，但我沒有詳細看合同的內容是否是關於不得洩漏有關在告訴人公司任職期間因職務知悉或持有之秘密，當時我若不簽該份合同，我就無法在告訴人公司工作，所以我也沒有詳細看合同內容或注意合同的內容是否對等；我將起訴書附表二各編號所示之檔案寄送至我私人所有之電子郵件信箱，是因爲我從進入告訴人公司的第一天起就習慣性將我在公司沒有做完或看不懂的報告寄回家，在家繼續做，對於公司而言，這是員工盡職的表現；再者，我在華星公司服務時所申請之「紫外有機發光裝置」發明專利，在具體實施方式中所提及之第二電極材料「鎂、銀」，這是業界習知的材料，也公開在文獻上，並不是告訴人公司的專利；在申請「有機電致發光二極管有機材料蒸鍍用掩模裝置」發明專利，所提到的「通過數張分掩模板拼接於掩模板框架上」技術，也是業界習知並廣泛應用，不是告訴人公司自行開發的技術等語；其辯護人則以：被告王宜凡寄送告訴人公司內部檔案至其外部私人信箱係爲及時完成告訴人公司所交付之工作，且寄送郵件時告訴人公司並無任何阻擋機制，是被告王宜凡主觀上無從認知這是屬於告訴人公司的營業秘密或工商秘密，且被告王宜凡並無洩漏工商秘密罪之主觀犯意，亦從未將外寄之資料洩漏予任何人知悉，且起訴書附表二各編號所示之內容均不具機密性

。又被告王宜凡申請專利之「紫外有機發光裝置」中，於具體實施方式中所提及之電極材料「鎂、銀」，告訴人公司早於94年5月31日申請中華人民共和國專利「有機發光二極管」時即已揭露；被告王宜凡所申請「有機電致發光二極管有機材料蒸鍍用掩模裝置」專利中，所表彰之技術手段為一種進行蒸鍍時所使用之掩模裝置結構設計，與起訴書附表二編號3第3個檔案之內容僅為某種供應鏈討論，並無記載任何裝置結構設計，顯為完全不同之內容，且該專利說明書所提到「數張分掩模板拼接於掩模板框架」之技術，早於韓國三星電子於2003年6月3日申請美國專利「MASK AND MASK FRAME ASSEMBLY FOR EVAPORATION」中被揭露，張網技術屬於此技術領域中先前技術，並非告訴人公司所稱之機密資訊；被告王宜凡於離開告訴人公司時，固然有簽署競業禁止約款，但在此項約款當中，告訴人公司並未提供相對應的補償措施，因此此項競業禁止約款係屬無效等語為其辯護。

七、經查：

（一）被告連水池部分：

1. 被告連水池是否為依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密義務者：

告訴人公司之服務守則雖規定：「本公司員工應遵守下列服務守則：…5.絕對保守營業秘密，於營業秘密無論是否為業務範圍，均不得洩漏、告知、交付或移轉予任何第三人，離職後亦同。…前項營業秘密係指乙方於工作期間所持有或知悉公司研發/營業活動有關之資料或資訊，包括但不限於附件一之機密資訊、公司之各種研發資訊、商情分析…以及其他經公司標示有『極機密』及『機密』之資料與資訊。」等情，有告訴人公司提出之員工手冊1份在卷可考（新竹地檢101年度他字第2094號卷《下稱他2094卷》一68頁），然被告連水池於調詢時供稱：我沒有詳細看服務守則等語（他2094卷一第198頁背面）；告訴代理人桑和蓓於偵查時陳稱：連水池在告訴人公司任職或離職時，並沒有簽署保密條款或競業禁止條款的文件，連水池的聘僱合約也找不到；告訴人公司對於防止離職員工洩密，沒有具體方法，除提醒員工之外，友達公司也時常發公告給員工提醒競業禁止條款規定等語（他2094卷二第243頁、卷三第670頁）。是被告連水池上述辯稱其未曾與告訴人簽訂應保守因業務知悉或持有工商秘密之契約等情，並非無據。另告訴人公司雖以員工手冊或公告之方式提醒員工需保守公司之營業秘密，然此究為告訴人公司單方面

公告事項，是否可視為已經雙方意思合致之契約內容，並非無疑。再觀諸，員工手冊之內容除有關服務守則有有關營業秘密的規定外，尙就員工禮儀及辦公環境等事項為規範等情，有員工手冊4-2AUO人禮儀在卷足憑（他2094卷一第67頁），據此，益徵告訴人員工守則應僅係告訴人單方面公告並提醒員工應遵守之事項，而非可作為強制員工應遵守之契約內容。是無法以告訴人公司單方面所制訂員工守則有記載員工應絕對保守營業秘密等情，即據此引為被告連水池係依契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務者。

2. 於被告連水池扣案電腦之華星公司規劃報告投影片檔案中第4頁「HVA技術」之左邊圖形（即新竹地檢101年度偵字第10325號卷《下稱偵10325卷》一第183頁上方圖檔）是否係告訴人公司PSA第一次紫外線製程及材料之架構等機密內容：

(1) 被告連水池供稱：「HVA技術」及「4-mask技術」的圖檔都是已經公開的技術，而且這些圖都只是概念的圖，沒有任何參數等語（偵10325卷三第559頁）。

(2) 觀諸華星公司規劃報告投影片檔案第4頁之「HVA技術」左邊圖形（下稱華星公司規劃報告之「HVA」圖檔），確僅為概念性的描述並無記載任何製程參數等情，有該圖形在卷可證（偵10325卷一第183頁上方圖檔）。又佐以2009年SID論文：Te-Sheng Chan et al.，「Advanced MVA III Technology for High-Quality LCD TVs」, SID 2009 Digest, P 776-779（偵10325號卷三第736至739頁，中譯本於本院智易10卷二第第294至295頁）摘要內容：本文展示一種先進的多域垂直配向式（MVA）技術，即沒有突起設計的進階型多域垂直配向式（AMVA）III（AUO或者第三代的進階型MVA）技術。採用了進階型多域垂直配向式（AMVA）III技術的薄膜電晶體管液晶顯示器具有高的光學透過率，（比傳統的MVA的透過率高20%），高的靜態對比（>8000:1），快速的響應時間，低的色偏，並且不會出現動態模糊現象。這項進階的技術已經開始應用於液晶電視的大規模生產。圖5展示了聚合物持續配向式（PSA）製程的流程圖〔3〕，為了使液晶層形成一個預傾角，電場被加在液晶層（步驟1→步驟2），電的接觸端（pad）被設計用來加電壓到每一個影像單元（pixel），當我們在整片液晶層的上下兩側施加合適的電壓並同時提供某強度的紫外光照射時，預傾角就形成了（步驟

3)，經過紫外光照射後，能夠給予液晶分子提供合適預傾角的聚合物層 (polymer layer) 就形成了聚亞醯胺 (polyimide) 表面上，此提供一個適當的預傾角 (步驟4)。聚合反映結束後，聚合物表面的粗糙大大的增了超過 10nm。而該圖5 (偵10325 卷三第738 頁)之圖形與上開華星公司規劃報告「HVA 技術」圖檔，比對結果，不論是圖示或文字表達均完全相同等情，有該論文在卷可考；2010年SID 論文：Po-Lun Chen , 「Green TFT- LCD Technologies 」,SID 2010 Digest , pp .108-111 (本院智易10卷二第78至80頁，中譯本於本院智易10卷二第150 至151 頁)，論文之3.1 面板穿透率提升-VA 液晶模式，有效的穿透率提升包括液晶穿透率提升，開口率提升和像素排列方法。爲了不斷提高TFT-LCD 面板的表現，在過去的幾年中我們開發了一系列的垂直配向 (VA) 技術 (如圖1)。最近友達光電開發的AMVA5 技術和之前的AMVA1 技術相比，不僅將對比率提高到16000 :1，液晶的穿透率也提升了30%，這主要得益於新開發的聚合物穩定的垂直配向技術 (PSA) 有效的改善了液晶轉動產生的暗線。圖2 友達光電的AMVA5 利用PSA 技術提高面板穿透率來降低功耗、實現綠色LCD。(a) 基本的PSA 製作流程和液晶分子重新配向的原理。並說明圖2 (本院智易10卷第79頁) 第一步：不加電壓。第二步：加電壓。第三步：加電壓+紫外光。第四步：不加電壓。且該論文之圖2 經與華星公司規劃報告「HVA 技術」圖檔比對結果，不論是圖示或文字表達均完全相同等情，有該論文在卷足參。據此，足認華星公司規劃報告「HVA 技術」圖檔係已於公開文獻上所公開之技術。

(3)再參以告訴人公司所指訴被告連水池洩漏之告訴人公司「PSA Technology」第22頁圖檔 (即起訴書附表一編號2 之圖檔，見偵10325 卷二第401 頁，下稱「PSA Technology」報告圖檔) 與華星公司規劃報告「HVA 技術」圖檔之比較結果，尚有下列不同點：製程表達方式不同：華星公司規劃報告是以Step1 ~Step4 表示製程順序；告訴人公司「PSA Technology」報告圖檔係以 (1) ~ (4) 表示製程順序。PI文字說明不同：華星公司規劃報告有PI s ide chain 文字說明；告訴人公司「PSA Technology」報告圖檔僅有文字說明。電壓表達不相同：華星公司規劃報告並無給予確定之電壓數值；告訴人公司「PSA Technology」報告圖檔給予明確之的電壓數值等情。況且，告訴

人公司「PSA Technology」報告圖檔中有關電壓數值之記載，此應為該圖檔所表達製程中之重要數據，且為該圖檔中真正具有經濟價值之處，然華星公司規劃報告之「HVA 技術」圖檔卻未見此數據之記載。是華星公司規劃報告之「HVA 技術」圖檔若果真係出自告訴人公司「PSA Technology」報告圖檔，豈會獨漏此重要數據。

(4) 綜上，華星公司規劃報告之「HVA 技術」圖檔，僅為概念性之說明，並未說明有關製作流程的參數，例如UV光的光強度、UV光的曝照時間等，他人圖檔概念性之表達，尚須由其本身的經驗嘗試錯誤實驗後調整所需之參數，最後才可製造出產品。又告訴人公司PSA 技術早已在學術論文公開，但在文獻中未見給予電壓參數，該電壓參數則在告訴人公司「PSA Technology」報告圖檔中得以窺知。然華星公司規劃報告「HVA 技術」圖檔中，並未有該具有經濟價值之電壓參數之記載，據此，華星公司規劃報告「HVA 技術」既是文獻上已公開之技術，且未記載告訴人公司具有經濟價值之電壓參數，自難以此認定被告連水池有何洩漏告訴人公司PSA 第一次紫外線製程與材料的架構。

3. 於被告連水池扣案電腦之華星公司規劃報告投影片檔案中第5 頁之「4-mask技術」（即偵10325 卷一第183 頁下方圖檔）是否係告訴人公司有關於5 道光罩縮減為4 道光罩之關鍵流程之機密內容？

(1) 華星公司規劃報告第5 頁之「4mask 技術」圖檔內容（下稱華星公司規劃報告之「4 mask技術」圖檔），僅概念性之描述，並無任何製程參數，其所表達之技術為第一道蝕刻中金屬層凹進於光阻層，此為濕蝕刻是四面八方的蝕刻特性，再搭配「metal (wet)」之文字說明可知第一道蝕刻係以濕蝕刻的方式蝕刻金屬層。第二道蝕刻中歐姆接觸層、半導體層突出金屬層，此為乾蝕刻特性，再搭配「2-layer & PR (dry)」之文字說明可知第二道蝕刻係以乾蝕刻的方式蝕刻光阻層、歐姆接觸層、半導體層。第三道蝕刻中金屬層凹進於光阻層下，此為濕蝕刻是四面八方的蝕刻特性，再搭配「Channel metal (wet)」之文字說明可知第三道蝕刻係以濕蝕刻的方式再次蝕刻金屬層以形成TF T的源極以及汲級。第四道蝕刻中歐姆接觸層金屬層，因為乾蝕刻具有向下蝕刻特性，再搭配「n cut (dry)」之文字說明可知第四道蝕刻係以乾蝕刻的方式蝕刻歐姆接觸層。亦即利用4 道光罩製程，第一道為濕蝕刻、第二道為乾蝕刻、第三道為濕蝕刻、第四道為乾

蝕刻，將原本需要5 道光罩製程縮減為4 道光罩製程之流程等情，有華星公司規劃報告之「4 mask技術」圖檔列印存卷可考（偵10325卷一第183頁下方圖檔）。

(2)93年6 月1 日公告之中華民國專利公報編號589663號「平片顯示器及其製造方法」專利案中文發明摘要記載：本發明提供一種平面顯示器，其係藉由四道蝕刻程序來定義第二層金屬層（M2）、摻雜的半導體層和半導體層。第一道是濕蝕刻，以第一光阻層為罩幕，濕蝕刻定義第二金屬層。第二道是含氧的乾蝕刻，在蝕刻期間第一光阻層被部分灰化而變成具有通道圖案的第三光阻層，並同時蝕刻摻雜的半導體層和半導體層。第三道是濕蝕刻，以第二光阻層為罩幕，濕蝕刻第二金屬層。第四道是乾蝕刻，第二光阻層為罩幕，蝕刻摻雜的半導體層，以定義出源極和汲極。上述之第二金屬層藉由兩次的濕蝕刻製程使其邊緣內縮，而摻雜的半導體層則藉由一次的含氧乾蝕刻製程使其邊緣往內縮至與第一次蝕刻後的第二金屬層之邊緣相同。藉此，可以縮小第二金屬層的邊緣與摻雜的半導體層邊緣之距離等情，有上開專利公報在卷可稽（本院102 年度審智易字第9 號卷《下稱本院智易9 卷》第128 頁），是該專利所揭露之製程亦為第一道濕蝕刻、第二道乾蝕刻、第三道濕蝕刻、第四道乾蝕刻。

(3)2006年公開於PKLT弘榮光罩公司網站上有關於Slit Mask 文章中提到Slit mask 不是在曝光領域直接曝光，而是經由狹窄的線曝光。與一般曝光比起來，會降低光量並因回折的效果，僅有部分photoresist 被曝光而剩下薄層的photoresist，使非曝光、全面曝光、部分曝光之三領域合成一張mask。使用該mask時，在經過全面曝光所形成之pattern 部分做一回etch後，透過ashing工程，部分曝光之領域被patterning，再由第二回工程將部分曝光的部分蝕刻掉。此表示，本來需要2 張mask的工程，因slit mask 僅用1 張即可進行工程，使工程簡單化，並於舉例說明中記載：3.可以使用濕蝕刻源極（Source）層以及汲極（Drain）層。4.可以使用乾蝕刻的方式蝕刻半導體層（Active）層。5.可以使用濕蝕刻的方式蝕刻源極（Source）層及汲極（Drain）層。6.可以使用乾蝕刻的方式蝕刻摻雜的半導體（N+）層等情，有上開網站上列印資料存卷可憑（偵10325 卷三第834 至835 頁），是該網站上所表達之製程亦為第一道濕蝕刻、第二道乾蝕刻、第三道濕蝕刻、第四道乾蝕刻。

- (4)告訴人「AU0、RD000」投影片第4頁「RDA00-好的成果」左邊圖檔（即起訴書附表一編號1之圖檔，下稱告訴人公司「AU0、RD000」之4mask圖檔，見偵10325卷二第325頁）所表達者，為面板中TFT元件的蝕刻是使用4道光罩（mask），其中兩道是濕蝕刻，另外兩道是乾蝕刻，第一道蝕刻中金屬層凹進於光組層下，因為濕蝕刻是四面八方的蝕刻特性，所以可推知第一道蝕刻係以濕蝕刻的方式蝕刻金屬層。第二道蝕刻歐姆層、半導體突出金屬層，因為乾蝕刻具有向下蝕刻特性，所以可推知第二道蝕刻係以乾蝕刻的方式蝕刻光阻層、歐姆接觸層、半導體層。第三道蝕刻中金屬層凹近於光阻層下，因為濕蝕刻是四面八方的蝕刻特性，所以可推知第三道蝕刻係以濕蝕刻的方式再次蝕刻金屬層以形成TFT的源極及汲極。第四道蝕刻中歐姆接觸處層突出金屬層，因為乾蝕刻具有向下蝕刻特性，所以可以推知第四道蝕刻係以乾蝕刻的方式蝕刻歐姆接觸層。可知告訴人公司「AU0、RD000」之4mask圖檔，所利用之4道光罩製程亦為第一道濕蝕刻、第二道乾蝕刻、第三道濕蝕刻、第四道乾蝕刻，而將原本需要5道光罩製程縮減為4道光罩製程等情，有告訴人公司「AU0、RD000」之4mask圖檔在卷足證（偵10325卷二第325頁）。
- (5)據上可知，華星公司規劃報告之「4 mask技術」圖檔所表達者為，僅係4mask流程之概念性說明，即於將5道光罩製程縮減為4道光罩時，其所採取之步驟為第一道濕蝕刻、第二道乾蝕刻、第三道濕蝕刻、第四道乾蝕刻，然此步驟已於上述93年6月1日公告之中華民國專利公報編號589663號「平片顯示器及其製造方法」專利案及PKLT弘榮光罩公司2006年網站上有關於Slit Mask文章中所揭露，上開製程顯已不具有秘密性。除此之外華星公司規劃報告之「4 mask技術」圖檔，並未說明任何有關製作流程的參數，例如：光組材料、曝光的強度、曝光的時間、曝光的波長、乾蝕刻的氣體選擇、氣體的流量、氣體混和的比例、濕蝕刻溶液選擇、溶液的比例、蝕刻時間等等，他人經由上開圖檔概念性的表達，由其本身的經驗嘗試錯誤實驗後調整所需的參數，最才可製作出產品。是華星公司規劃報告之「4 mask技術」圖檔與告訴人公司「AU0、RD000」之4mask圖檔比對結果，渠等對於4道光罩的製程雖均採第一道濕蝕刻、第二道乾蝕刻、第三道濕蝕刻、第四道乾蝕刻，然此步驟既已於其他文獻、專利案中已揭露，即無秘密性可言。

- (6)再觀諸告訴人公司與員工所簽訂之聘僱契約第二章營業秘密之二、業務保密：1.乙方（即員工）服務於甲方（即告訴人公司）期間，應積極提供甲方其個人知識、技術及其他有價值之貢獻等語（偵10325 卷二第229 頁）。益徵，企業之所以願意以高薪聘僱員工，大部分均係借重於其個人本身所具備之知識及技術，亦期望員工於任職期間能竭盡所能的貢獻其所知及所能，是員工運用其自身之知識或技術所製作之報告，自與因其職務關係所接觸或持有之他人工商秘密，自屬有別，不容混為一談。且是否為工商秘密，並非僅由營業人主觀上認為秘密為斷，仍需在客觀上有一定之私密性，非該行業所熟知或習見之技術，使足當之。是員工運用其於公開文獻上所得知之知識或技能所製作之資料，縱使該內容於與他公司所謂機密文件中資料雷同，亦無法據此認定有何洩漏他人工商秘密可言。
- (7)綜上，華星公司規劃報告之「4 mask技術」圖檔中製程之步驟既已為公開之文獻所揭露，即未具有秘密性，並非刑法第317 條洩漏工商秘密罪所要保護之對象，縱使上開檔案內容與告訴人公司所謂之機密文件雷同，亦無法對被告連水池以該罪相繩。除此之外亦無其他事證證明被告連水池有何洩漏告訴人公司5 道光罩縮減為4 道光罩之關鍵流程之具體事證，自難以逕行認定被告連水池有洩漏告訴人公司5 道光罩縮減為4 道光罩之關鍵流程之具有經濟價值之商業機密。
- 3.另被告連水池扣案筆記型電腦中上存有告訴人公司「L CD TV 2012 Q2 Product Poadmap」投影片檔案，該檔案之製作日期為2012年4 月等情，有上開投影片檔案各頁頁尾註記可資佐證（他2094卷一第203 至213 頁背面），然參之被告連水池於100 年9 月15日已自告訴人公司離職乙情，上開檔案資料既係於被告連水池離開告訴人公司所製作完成，姑且不論上開檔案資料是否係告訴人公司具有經濟價值之工商秘密，其非被告連水池任職於告訴人公司期間，因業務上所持有之告訴人公司內部資料甚明。則酌以被告連水池扣案筆記型電腦中猶存有上開非因業務上所持有之告訴人內部資料等情。益徵，被告連水池供稱，上開扣案之華星公司規劃報告，係華星公司之員工所傳送等情，並非可完全排除其可能性，是被告連水池筆記型電腦中所持有之上開華星公司規劃報告內容果真源自於其任職於告訴人公司時所製作或所接觸之「AUO 、RD000 」、「PSA Technology 」檔案內容，仍有疑義。

4. 至於告訴人公司已以4道光罩之製程生產液晶顯示器而可降低其生產成本之事實，已為業界所知悉而非告訴人公司所主張之營業秘密等事實，業據告訴代理人於本院審理時到庭陳稱：同業已經知道我們公司已經利用4道光罩的製程生產顯示器，只是如何將5道製程變成4道製程的詳細過程不知道等語（本院智易10卷四第158頁），核與被告連水池於本院審理時供稱：LCD的製造廠商在SID年會上都會報告其各自開發的製程及量產情形，所以同業知道友達有在研發4道光罩的製程，至於友達公司是否有利用4道光罩的製程生產顯示器，只要拿製成的產品去分析就可知道等語（本院智易10卷四第153頁背面），是告訴人公司利用4道光罩的製程生產液晶顯示器之情，既已為業界所通曉，則告訴人利用4道光罩之製程已降低製造成本，提升競爭力之情，即非具有經濟價值之商業機密，則告訴人公司「AUO、RD000」之4mask圖檔中，所表達告訴人擁有4道光罩技術的內容亦不具有商業機密性。

(二) 王宜凡部分：

1. 被告王宜凡是否為依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密義務者？

(1) 被告王宜凡於90年9月20日受雇於告訴人公司時，與告訴人簽訂聘僱契約中，簽名表示願意遵守聘僱契約中有關於營業秘密所約定：「1. 確實履行公司維護公務機密措施各項規定。2. 因職務關係所知悉之公務機密，絕不洩漏」；復於離職時，簽署離職人員營業秘密和智慧財產權遵守聲明書，切結「離職後一年內絕不將因職務上所知悉之營業秘密為第三人持有或知悉」，有間接員工聘僱契約書、離職人員營業秘密及智慧財產權遵守聲明書在卷可證（偵10325卷二第228至236頁），是被告王宜凡服務於告訴人公司，其對於因業務知悉或持有之告訴人公司營業秘密，負有保守之義務，甚為顯明。

(2) 至於被告王宜凡雖辯稱，其簽訂上聘僱契約時並未詳細審閱契約內容，因為不簽我就沒有工作，其不清楚聘僱契約是否有約定不得洩漏有關在告訴人公司任職期間因職務知悉或持有之秘密等語（本院智易10卷二第30頁背面、卷四第155頁）。惟被告王宜凡既係因職務關係始能獲知告訴人公司上開營業秘密，而倘該秘密又屬刑法洩漏工商秘密罪所欲保護之對象，考量刑法對洩漏工商秘密者加以處罰，目的即在鼓勵工商企業研發、創新，如謂員工得因離職即任意外洩工商企業投入心力研發、創新之成果，顯非事

理之平，亦失刑法上開規範保護之目的，被告王宜凡上開主張縱然屬實，亦難因此認定被告王宜凡對其因職務知悉告訴人公司上開商業秘密不負保密之義務。

2. 起訴書附表二各編號所示之檔案是否為刑法第317 條洩漏工商秘密罪所保護之客體？

起訴書附表二各編號之檔案資料內容係包含告訴人公司就 OLED 顯示器相關技術之廠商基本資料資料、研發進度、產品進度、研發成果、降低成本策略、客戶需求分析、驗證資料、產能規劃、良率分析、製程、圖說、預算投資及 AM OED 前瞻研究之研發成果，其對告訴人公司具有如附表二各編號「機密內容」欄所示之機密內容，及如「說明」欄所載之商業上經濟價值等情，業據告訴人公司指訴明確（偵10325 卷一第33至37頁）；並經告訴人公司 LED 部門員工即徐土峰於偵查中具結證述相符（偵10325 卷三第507 至510 頁）。另佐以證人徐土峰於偵查中亦具結證稱如附表二各編號所示之檔案資料係由負責該項之工程師及其主管掌控，不能分享其他同事等語（偵10325 卷三第508 頁）。並觀諸上開檔案資料包括告訴人之合作廠商、未來產品產能之規劃、研發之方向、良率分析等資料，均係事關公司商業之營運計劃而且具有經濟效益，就告訴人公司營運利益而言，確屬不能公開之資料。況且，上開檔案資料均已註記「Confidential」之浮水印標示，告訴人公司對於屬於具有經濟價值之商業機密，亦有當適當之保密措施。是如附表二各編號所示之檔案資料中之部分內容確屬告訴人公司具有經濟價值之商業機密，而上開檔案內容既無業經公開於外之事證，自為刑法第317 條洩漏工商秘密罪所保護之對象。

3. 被告王宜凡是否有洩漏其因業務所持有之告訴人公司之工商秘密？

(1) 被告王宜凡將業務上所持有之如附表二各編號所示之檔案資料，自100 年5 月2 日至同年9 月29日以寄發電子郵件之方式，自其告訴人公司所配發之員工內部信箱寄送至其私人所有之外部電子信箱等情，業經被告王宜凡供承在卷（本院智易10卷二第30頁），並有被告王宜凡上開寄送附表二各編號之電子郵件列印在卷可佐（偵10325 卷一第40 至114 頁）。是被告王宜凡將因業務關係所持有之屬於告訴人公司商業上秘密之相關文件寄送至其私人電子郵件之事實堪予認定。

(2) 惟刑法第317 條、第318 之2 以電腦設備犯工商秘密罪，

除客體需符合「秘密性」外，尚須有「洩漏」之行爲爲其構成要件，即必行爲人已將秘密洩漏予他人得悉爲必要，倘行爲人僅將其原已持有之他人未經公開之資訊予以移置他處，而未使他人得悉，則不成罪。然依卷內事證，僅能證明被告王宜凡有將上開資料以電子郵件之方式，自員工內部信箱寄至其私人之外部信箱，即有關資料仍在被告王宜凡持有之中，縱其辯稱，將上開資料寄至其外部信箱係爲工作之關係所爲等情是否屬實，仍有疑義，然亦不能以被告王宜凡上開行爲即遽認被告王宜凡有將上開資料洩漏予他人之行爲。

(3)再者，被告王宜凡在大陸所申請「紫光有機發光裝置」專利之內容主要爲：紫外有機發光裝置100 包含紫外有機發光元件110 以及保護層120，其中紫外有機發光元件11具有第二電極111、紫外有機材料層112 以及第一電極113，紫外有機發光元件110 可發出紫外光用於有益於人類的健康及生活，保護層120 可設置於紫外有機發光元件110 發光側，且保護層120 可用以保護紫外有機元件110；其於說明書第〔0031〕段揭露電極的材料爲銀、鋰、鎂、鋁及其任意合金等情，有該發明專利書在卷可查（偵10325 卷三第660 至665 頁）。是上開專利書的主要內容爲，具有保護層且可發出紫外光之紫外光有機發光裝置。而告訴人公司附表二編號「OLED material strategy」檔案內容主要爲：告訴人公司對於OLED材料供應商長期合約的規劃方向，以及選擇OLED材料的評估，亦即告訴人公司未來可能使用的OLED材料以及廠商等情，此有「OLED material strategy」檔案內容附卷可考（偵10325 卷一第50至51頁），是「OLED material strategy」檔案之內容是一個內部評估的實驗結果，與被告王宜凡所申請之「紫光有機發光裝置」專利之內容並不相同。另「OLED material strategy」檔案之第7、9 頁（即偵10325 卷一第51頁）雖說明陰極的材料爲Mg/Ag，與上開王宜凡專利申請書所揭露之電極材料部分相同，然專利申請書中尚揭露其他不同的金屬電極，例如鋰、鋁及其他任意合金，與「OLED material strategy」檔案所揭露之內容並非完全相同。況且OLED中常見的第一電極材料爲透光的ITO、IZO，第二電極材料爲鋁、鋰、鎂、銀及其合金，是「OLED material strategy」中所說明陰極之材料已常見於OLED的電極材料，自不能以被告王宜凡所申請之「紫光有機發光裝置」內容中所揭示之電極材料與「OLED material strategy」檔案

中所提到之電極材料部分相同，即據以認定被告王宜凡有洩漏告訴人公司附表二編號3「OLED material strategy」之內容。

(4)被告王宜凡另一在大陸申請「有機電致發光二極管有機材料蒸鍍用掩模裝置」專利摘要為：本發明係提供一種有機電致發光二極管有機材料蒸鍍用掩模裝置，包含掩模板框架20以及分掩模板22，分掩模板22設置於掩模板框架上20上，兩分掩模板22間則設有間隙24，每個分掩模板22設有有效區220 以及無效區222，透過該掩模裝置將有機材料蒸鍍製作有機電致發光二極管，則有機電致發光二極管有機材料蒸鍍用掩模裝置通過數張分掩模板拼接於掩模板框架上，實現了有機電致發光二極管有機材料蒸鍍用掩模的大尺寸化，同時有利於大尺寸有機電致發光二極管的有機材料的蒸鍍等情，有該發明專利書在卷可查（偵10325 卷三第682 至691 頁）。而告訴人公司附表二編號3 第3 個檔案「OLED supply chain discussion-000000」檔案內容主要為：OLED材料、OLED的驅動IC、蒸鍍遮罩（shadow mask）的供應商分析，及有關於Tension Machine 實驗機拉伸精細金屬遮罩（fine metal mask，FMM）時，一維與二維方向上的精細金屬遮罩的位置偏移實驗結果，亦即係評估使用精細金屬遮罩用於OLED蒸鍍時的實驗結果等情，有上開檔案內容附卷可參（偵10325 卷一第53至60頁）。足認該檔案內容與被告王宜凡上開專利申請內容係蒸鍍製作有機電致發光二極管的掩模板之內容，顯不相同。又OLED製作過程中需要將材料蒸鍍於基板上，蒸鍍技術通常使用蒸鍍遮罩（shadow mask）作為遮罩的器具，「OLED supply chain discussion-000000」檔案中說明蒸鍍遮罩的供應商，將蒸鍍遮罩區分成兩類：一般遮罩（common mask）以及精細金屬遮罩（fine metal mask，FMM），檔案內之Tesion Machine實驗機均為對於精細金屬遮罩所作之測試，然由檔案內容無法直接說明有一個或多個精細金屬遮罩拼接於框架上，是上開內容是否含有表達「通過數張分掩模板拼接於掩模板框架上」之技術內容並非無疑。再觀諸2005年10月18日公告之美國第US6,955,726B 2 號「Mask and mask frame assembly for evaporation」專利中所揭露內容：一掩模板框結構，其包括：一具有開口之掩模板框架，以及一具有至少二個以上的分掩模板（單位掩模板），其中每一分掩模板（單位掩模板）之端部皆以張力拼接固定於掩模板框架。又每一分掩模板（單

位掩模板)包括：一個單位掩模圖樣，並且相互重疊拼接以達到預設寬度，使成爲一體之掩模板。其中每一分掩模板(單位掩模板)在重疊拼接部皆具有一凹面用以保持重疊拼接部厚度可與每一單位掩模板相等。據此，掩模板框架結構可增加掩模圖樣尺寸，致減少蒸鍍圖樣中形變的範圍，協助調整整體蒸鍍圖樣以及避免於其餘部位亦受到蒸鍍影響等情，有該專利說明書及中譯本摘要附卷可查(本院智易10卷二第107至115頁背面、第290至292頁)，據此，足認「張分掩模版拼接於掩模板框架上」係已公開之技術，自難認定「張分掩模版拼接於掩模板框架上」之技術爲告訴人公司具有經濟價值之商業機密。

(5)綜上，被告王宜凡雖持有如附表編號二各編號所示之告訴人公司具有經濟價值之商業機密，並將之以電子郵件方式寄送至其外部電子信箱，然除此之外，卷內事證並無被告王宜凡將上開商業秘密提供予第三人之「洩漏」行爲。又就被告王宜凡於大陸申請之「紫外有機發光裝置」及「有機電致發光二極管」專利申請書內容，與被告王宜凡所持有告訴人公司部分屬於商業機密之「OLED material strategy」、「OLED supply chain discussion-000000」(即起訴書附表二編號3第1、3個檔案)內容比對後，二者之內容並不相同。至於上述被告王宜凡專利申請書中所提及之第二電極材料「鎂、銀」及「通過數張分掩模板拼接於掩模板框架上」之技術內容，或是常見於OLED的電極材料，或是已公開之技術，均因不具有秘密性，而非刑法第317條所要保護的客體，縱使上開內容於告訴人公司上開檔案中有相同之記載，亦與刑法第317條洩漏工商秘密罪之構成要件有間，更何況，告訴人公司附表二編號三第3個檔案內容，並未明顯揭露「通過數張分掩模板拼接於掩模板框架上」之技術。是自無法以被告王宜凡於大陸申請上開專利之內容及行爲，而遽以認定被告有洩漏告訴人如附表二各編號所示商業機密檔案內容之行爲。

七、綜上所陳，本案公訴人就被告連水池、王宜凡等人起訴之犯罪事實，所提出之證據，經逐一剖析，參互審酌，仍有合理之懷疑存在，尙未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其爲真實之程度，無從使本院形成被告連水池、王宜凡等人有罪之確信，本件既不能證明被告連水池、王宜凡等人罪行，揆諸前揭法條及判例意旨，自應爲被告連水池、王宜凡等人無罪判決之諭知。

八、未按，刑事訴訟之審判，採彈劾主義，亦即不告不理原則，

案件須經起訴，繫屬於法院，法院始有審判之義務，審判之事實範圍，自應以起訴之事實為範圍，如事實已經起訴而未予裁判或未經起訴而予裁判，既均違背上開原則，自屬當然違法，此觀刑事訴訟法第268條及第379條第12款規定自明；惟因國家對單一性案件僅有一個刑罰權，此種案件之全部事實自不容割裂，而應合一裁判，故同法第267條規定「檢察官就犯罪事實之一部起訴者，其效力及於全部」，此即所謂審判不可分，亦即審判事實範圍之擴張，此種事實之擴張，須以未經起訴之事實（學術上有稱為「潛在事實」）與已經起訴之事實（學術上有稱為「顯在事實」）俱屬有罪且互有實質上或裁判上一罪之不可分關係為前提，始無礙於審判事實與起訴事實之同一性，如其中之一部不能證明犯罪，既與他部無不可分關係，自無合一裁判之餘地，最高法院86年度台上字第3764號判決意旨可資參照。又刑事訴訟法並無如民事訴訟法得「擴張或減縮應受判決事項之聲明」之規定，是就與已經具體起訴之案件無上開單一性不可分關係之犯罪尚不得於準備程序或審判期日，逕以擴張起訴犯罪事實之請求代替訴之追加。本件到庭實行公訴之檢察官於104年1月23日準備程序中以言詞擴張犯罪事實（本院智易10卷四第14頁背面）：被告另洩漏告訴人公司「AUO AS外凸縮減」檔案中第4頁之「4mask 2W2D & 1W1D Process」資料（即偵10325卷三第435頁左上方圖檔），此部分亦涉以電腦設備洩漏工商秘密之犯行。然查，本件經檢察官具體提起公訴之以電腦設備洩漏告訴人如起訴書附表一編號1、2所示之機密圖檔之洩漏工商秘密部分，業因不能證明犯罪而應為無罪之諭知，已如前述，依上說明，自與檢察官未具體提起公訴之擴張犯罪事實部分無不可分關係可言，本院是無從另就檢察官擴張犯罪事實部分進行審理，附此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。

本案經檢察官郭維翰到庭執行職務。

中 華 民 國 104 年 4 月 30 日

刑事第四庭 法 官 王婉如

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

附表一

編號	檔名及機密圖檔	機密內容	說明
1	AUO、RD000，第4頁左邊圖檔	5mask（5道光罩）縮減到4mask（4道光罩）之關鍵流程	4道光罩之研發有利於開發大尺寸與高解析之面板，提升穿透率，降低面板成本。友達公司已將4道光罩技術應用於產品上。
2	PSA Technology，第22頁圖檔	PSA第一次紫外線製程與材料的架構	透過施加電壓及照紫外線之方式，可控制液晶的導向，減少控制液晶的擋光架構，可提升面板穿透率20%。友達公司是世界上第一個將PSA技術用於液晶電視生產之公司。

附表二

編號	寄件日期	檔 名	機密內容	說明
1	2011/5/2	110412 Vendor list for L4B	友達L4B廠OLED廠商基本資料	「廠商資料」是友達公司的機密文件，友達公司與王宜凡間的聘僱契約書第二章第一條約定必須遵守聘僱契約書附件

表 |
 | | | | 列的機密資訊，其中廠商資
 料 | | | | 已明列其中。王宜凡所洩漏
 之 | | | | 與友達公司合作的OLED廠商
 資 | | | | 料，確實為友達公司的營業
 秘 | | | | 密。

— |
 | 2 | 2011/7/15 | OLED Product | 1. 友達OLED產品發展進程 | 「OLED Product Roadmap
 | | | Roadmap00000000 | 2. 0000-0000OLED高PPI產 | 00000000」這份文件主要是
 友 | | | 品進程 | 達公司規畫對未來五年對
 OLED | | | | 3. 0000-0000軟性AMOLED | 產品發展的進程，此進程的
 訂 | | | 開發時程 | 定，需先經過長時間的評估
 及 | | | | 4. 3D在AMOLED的解決方案 | 研究，才確認了未來將開發
 的 | | | | 5. 3D在AMOLED的應用發展 | 產品規格，並以此產品規格
 為 | | | 0000-0000 | 發展的目標，此文件洩漏給
 華 | | | | 6. 節省成本研究結果資料 | 星光電，該競爭對手就可以
 知 | | | | 7. AMOLED優化 | 道未來友達公司所研發的產
 品 | | | | 方向、內容及規格，進而訂
 定 | | | | 出打擊友達公司的研發方向
 及 | | | | 產品策略，此屬於友達公司
 極 |

				機密文件。
3	2011/7/31	OLED material strategy, OLED supply chain-1026, OLED supply chain-000000	1.OLED降低成本的策略 2.2012 OLED面板需求的預估 3.OLED客戶需求分析 4.機台實驗結果	在這些文件中有包含了友達公司所訂定的現階段及未來所要搭配什麼樣的OLED材料的組成是由十幾層的有機料所組成，OLED元件是決定板光學的規格及使用壽命研發階段，友達公司會與許多材料廠商經過開發、測試、校等等的合作過程，決定淘汰不適合廠商，並選定能達成產品最佳化的材料廠商，這些料內容是經過友達公司長時間的研究、測試，支出高額的發成本，經過試誤，累積了豐富的經驗所得到的具有策略的最佳化結果。此文件洩漏給華星光電，該競爭對手不需

要 | | | | | 經歷這些過程，就可以迅速
 | | | | | 輕易地跳躍至與友達公司目
 前 | | | | | 相同的開發水準。此外，文
 件 | | | | | 內容還包含Tension Machine
 | | | | | (張網機) 實驗機的機構設
 計 | | | | | ，此張網機為友達公司自行
 研 | | | | | 發的機台，是製作OLED蒸鍍
 全 | | | | | 彩化製程所需金屬遮罩的機
 器 | | | | | ，也是友達公司極機密的資
 料 | | | | | 。

— | | | | |
 | 4 | 2011/8/12 | LTPS OLED | 低溫多晶矽OLED產能規劃 | 此份文件為友達公司總經理
 室 | | | | | 的一幕僚單位「策略規畫室
 」 | | | | | 定期所蒐集整理的報告，所
 蒐 | | | | | 集整理的範圍包括全球
 OLED的 | | | | | 產能，此為友達公司耗費相
 當 | | | | | 的時間、人力成本所產出的
 研 | | | | | 究成果，亦屬於重要的營業
 秘 | | | | | 密。此文件洩漏給友達公司
 的 | | | | |

				競爭對手，該競爭對手不需
要				付出任何時間、人力成本
，不				費吹灰之力就可以了解全球
的				產能需求，訂定出具有策略
性				的產能規畫，並降低其生產
成				本，對友達公司的競爭力造
成				影響。

5	2011/8/22	OLSC1 Weekly	1.工作週報	文件內容中所包含的良率解
析		Report-w134	2.OLED新產品研究報告	報告，是針對研發中的
OLED產			3.OLED產品良率分析	品在研發過程中所發生的各
種				瑕疵原因所做的研究分析報
告				，此研究分析報告可以使產
品				在量產時獲得較好的良率
，是				友達公司的營業秘密及重要
的				研發成果。此文件洩漏給華
星				光電，該競爭對手不需經過
試				誤的過程，即可獲得較佳的
良				率，對成本的降低及競爭力
有				重要的影響。

6	2011/8/25	OLED mask road map and forecast	OLED光罩研發進程2010-2013	文件內容包括友達公司至2013年OLED製程的金屬遮罩開發的規格及目標；OLED金屬遮罩是面板全彩化的關鍵技術，影響的是OLED產品解析度，這是友達公司的重要營業機密。此文件洩漏給華星光電競爭對手就可以知道未來友達公司金屬遮罩規格及內容可以訂定出打擊友達公司的研發方向及產品策略。
7	2011/9/19	2011-38-X397 DVT1-2 Red issue_00000000	1.OLED應用在產品上的技術資料 2.OLED光罩研發進程 0000-0000	內容含有友達公司對實驗性生產的樣本所做的良率解析報告，是友達公司的營業秘密文件如洩漏給華星公司，該競爭對手不需投入研發成本需經過試誤的過程，即可獲得

要				較佳的良率，此友達公司重
及				的研發成果，對成本的降低
				競爭力有重要的影響。
8	2011/9/21	00000000_Slim	1.AMOLED製程	此文件內容包含如何把
AMOLED		AMOLED, 110408_	2.AMOLED機台設備需求分	析
程		L4B OLED TF	析	方法，此非但為友達公司的
關		encap proposal,	3.友達L4B廠廠房規劃圖	鍵技術及營業秘密，關於軟
性		Flexible AMOLED	說	AMOLED的研發成果更是友達
公			4.前瞻軟性AMOLED研發進	司參與經濟部重要科專計畫
「			程0000-0000（與科專	前瞻軟性AMOLED顯示器研究
開			計畫強相關）	發計畫」的一部分，屬於受
管				制的國家敏感科技，限制輸
出				大陸。
9	2011/9/29	L4B investment	1.友達OLED投資預算評估	此文件內容包含友達公司新
加		to Kevin, FC	2.OLED機台配置、產能及	坡廠所投資的金額、產能及
配		Review L4B	價格表	置，內容精細到做出一片
		Investment的工作		AMOLED的面板所要經過的數
十		表		道製程有那些，及每一道製

程					所產生的費用為多少，這是
友					達公司的營業秘密。
10	2011/9/29	L4B OLED PPI	OLED PPI模擬實驗結果報	告	此份文件內容是針對TFT陣列
		simulation-0325			製程的極限模擬製作OLED面
板					，所做的解析度模擬實驗結
果					報告，此文件如洩漏給華星
光					電，該競爭對手就可以知道
未					來友達公司面板產品解析度
規					格，而可以訂定出打擊友達
公					司的研發方向及產品策略。